

第十三讲

复习:

① 介质极化的完整图像

$$\vec{E}_0 \Rightarrow \vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}_0 \Rightarrow q_p \Rightarrow \vec{E}_p \Rightarrow \vec{P} = \epsilon_0 \chi (\vec{E}_0 + \vec{E}_p)$$


② 介质中的高斯定理:

辅助矢量: 电位移矢量 $\vec{D}(\vec{r}) = \epsilon_0 \vec{E}(\vec{r}) + \vec{P}(\vec{r}) = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}(\vec{r})$

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{s} = q_f$$

- 1) 电位移矢量是一个辅助矢量, 本身不具有明确的物理意义。虽然其与源电荷产生的电场满足一样的高斯定理, 或者说 \vec{D} 与 \vec{E}_f 两种场的散度性质一样, 因两者具有可能不同的旋度性质, 仍然不能认为两者是一样的。
- 2) \vec{D} 满足的高斯定理始终是严格的。但 \vec{D} 与 \vec{E} 的关系只有在线形介质中才满足 $\vec{D}(\vec{r}) = \epsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}(\vec{r})$ 。一般情况下, 只能用 $\vec{D}(\vec{r}) = \epsilon_0 \vec{E}(\vec{r}) + \vec{P}(\vec{r})$ 。
- 3) 计算电介质的问题, 可以遵从 $q_f \rightarrow \vec{D} \rightarrow \vec{E} \rightarrow \vec{P} \rightarrow q_p$ 的计算次序, 最终用计算得到的 q_p 验证所得电场是否正确。

电容

(一) 定义

电容顾名思义是电荷的容器, 更本质讲是静电能的容器。它的用处有断电保护, 产生电场, 调谐振频率等。它在电学中具有重要的意义。

看一个最简单的电容器的定义: 设有两个导体组成的一个器件, 当两导体分别带 $+q, -q$ 电量时, 它们的电势差为 $\Delta V = V_1 - V_2$, 则定义这个电容器 (capictitor) 的电容 (capacitance) 为

$$C = \frac{q}{\Delta V} \quad \text{其单位为库/伏=法拉}$$

物理意义位: 单位电势差下, 存储在器件中的电量的大小。显然 C 越大, 同等条件下 (比如接同样的一个电池), 此电容器中存储的电荷量就越大, 反之亦然。

怎样给电容器充电？通常将导体分别接电池（源）两端，显然此时 ΔV 是确定的。

注意：本课程中 C 的定义事实上是“互电容”，定义对一种特定的电容器（只包含2导体，且规定其带等量异号电荷）。一般情况下，电容器可能包含任意多的导体，这种情况下，更普适的定义是 C_{ij} 电容系数

$$Q_i = \sum_j C_{ij} \cdot V_j$$

可描述任意导体体系中导体的带电量与电势的关系。总之 C 描述的是电量与电势的线性关系，其大小与几何结构有关。

(二) 举几个特例：

(1) 平行板电容：

设有两块导体平板（面积为 A ）平行放置（相距 d ），假设 $\sqrt{A} \gg d$ ，可以忽略边缘效应，平行板内部的电场可以看成均匀场。

板上的面电荷密度为 $\sigma = \frac{q}{A}$

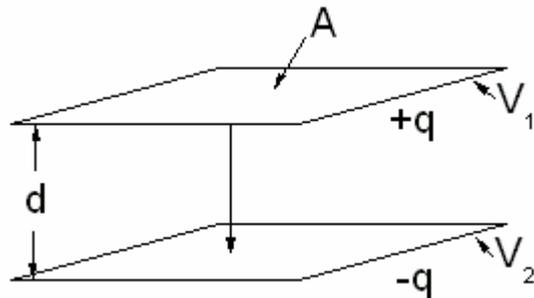
则两板中的电场：

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 A}$$

两板之间的电势差可得：

$$V_1 - V_2 = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q \cdot d}{\epsilon_0 A}$$

则电容可得：
$$C = \frac{q}{V_1 - V_2} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$



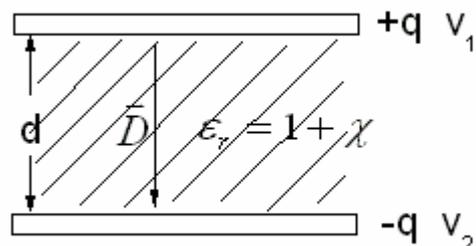
→ ① $C \propto A$ ，面积大则 q 大；

② $C \propto 1/d$ ， d 大则所需电压大；

如果平行板之间充满电介质，如何？

充电电压 ΔV 不变，求 q ？现在

假设 q 知，求 ΔV 更方便。



q 为 q_f ——自由电荷(不管极化电荷如何，我只关心 q_f)。由 \vec{D} 满足的高斯定理

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{s} = q_f \quad \text{可知} \quad D = \frac{q_f}{A} \quad \text{——均匀场,}$$

则可计算 E 场:

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{q_f}{\epsilon_0 \epsilon_r A},$$

进而可以计算电势差

$$V_1 - V_2 = Ed = \frac{q_f d}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$$

$$C = \frac{q_f}{V_1 - V_2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

介质的存在能提高电容 C，即提高电容器的储电能力。为什么？

\vec{E}_p “退极场”的存在

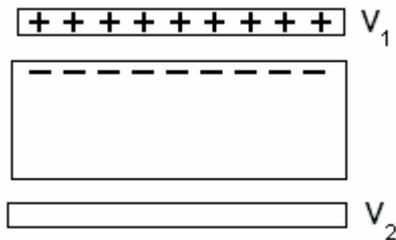
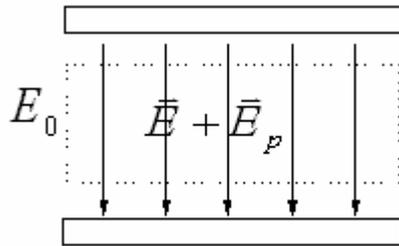
E_t 变小，因而电压变小

相同电荷，所需电压变小，电容变大。

换个角度看:

保持 $\Delta V = V_1 - V_2$ 不变，则电场相同。

加介质的作用是产生反向的极化电荷，外界条件要求达到相同的电势差（电场），只能通过追加 q_f 来实现



(2) 球状电容器

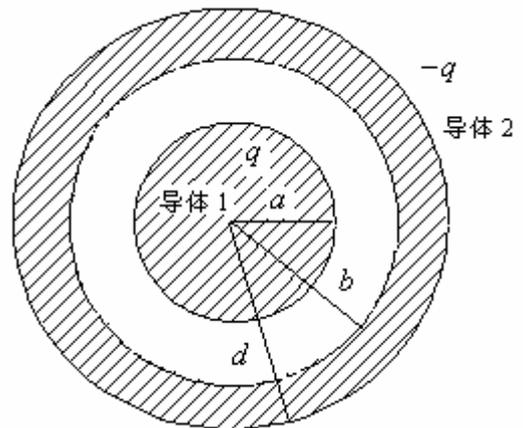
平板电容器虽然简单，但要求板较大（板小时有边缘效应，有漏电效应）。考虑其他形式的电容器，比如两个同心导体球（壳），

导体 1 $r \leq a$ q

导体 2 $b \leq r \leq d$ $-q$

它们之间填满介质 ϵ_r $a \leq r \leq b$

\vec{E} 在导体中为 0， \vec{D} 亦然



注意到对称性, $\vec{D}(\vec{r}) // \hat{e}_r$

由高斯定理 $\oiint \vec{D} \cdot d\vec{s} = q_f$, 取半径为 r 球面为高斯面

$$D(r)4\pi r^2 = q, \text{ 可得 } D(r) = \frac{q}{4\pi r^2}$$

线性 介质内部($a < r < b$)有 $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$, 则

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} \hat{e}_r$$

电势差因此可计算为:

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(-\frac{1}{r}\right) \Big|_a^b = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

电容值为:

$$C = \frac{q}{\Delta V} = 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r \frac{1}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = 4\pi \epsilon_0 \epsilon_r \frac{ab}{b-a}$$

讨论: ① $\epsilon_r = 1$ (空气, 真空), 则 $C = 4\pi \epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$

② ϵ_r (介质) 的存在增加电容, 物理原理与平板时一样。

③ 与平板电容的相似性: $b \approx a$ 时

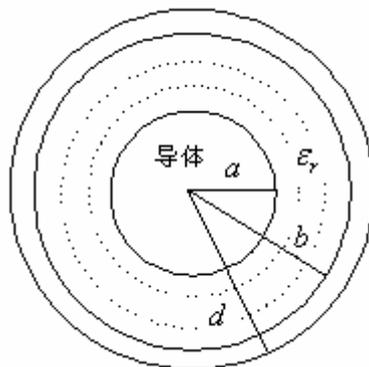
$$A_1 = 4\pi a^2 \quad A_2 = 4\pi b^2 \quad \bar{A} = \sqrt{A_1 A_2} = 4\pi ab$$

$$d = b - a, \text{ 则 } C = \epsilon_0 \frac{\sqrt{A_1 A_2}}{d} \approx \epsilon_0 \frac{\bar{A}}{d}$$

(3) 柱状电容器

柱状电容器介于平板与球形之间。
设电容器总长为 L

导体 1 $\rho \leq a$, 带电量 q



导体 2 $b \leq \rho \leq d$ $-q$

中间为电介质, 相对介电常数 ϵ_r $a \leq \rho \leq b$

由对称可知 $\Rightarrow \vec{E} // \hat{e}_\rho, \vec{E} = E(\rho)\vec{e}_\rho$

电容器中有电介质 ϵ_r , 根据介质中的高斯定理, 利用 \vec{D} 计算方便许多

$$\oiint \vec{D} \cdot d\vec{s} = q_f$$

$$D(\rho) \cdot 2\pi\rho \cdot h = \frac{q}{L} \cdot h$$

$$D(\rho) = \frac{q}{2\pi\rho L}$$

因介质为线性介质 $E(\rho) = \frac{D(\rho)}{\epsilon_0\epsilon_r} = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r\rho L}$, 由此可计算电势差

$$\Delta V = V_a - V_b = \int_a^b E(\rho) d\rho = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \ln(\rho) \Big|_a^b = \frac{q}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

$$\text{则电容为: } C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(b/a)}$$

讨论:

(i) ϵ_r 的存在使得电容变大, WHY? 极化电荷产生在介质与金属的界面上, 在效果上“抵消”自由电荷的影响, 因而使得体系可以存储更多的电荷。

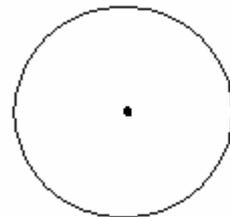
(ii) $b - a = d \gg a$ 时, 回到平板电容器?

$$\ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln\left(\frac{a+d}{a}\right) = \ln\left(1 + \frac{d}{a}\right) \approx \frac{d}{a}$$

$$C \approx 2\pi\epsilon_0\epsilon_r L \cdot \frac{a}{d} = \epsilon_0\epsilon_r \frac{A}{d}$$

(4) 单个导体的电容

单个导体也可以贮存电荷, 此时假设另一带等量异号电荷的导体为地球, 或放 ∞ 处导体球。半径为 R , 电势



为 V 的导体球，贮存多少 q ？（实际问题中往往知道 V ，不知 q ，此处计算时由 $q \rightarrow V$ 更方便）

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

$$V = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$C = q/V = 4\pi\epsilon_0 R$$

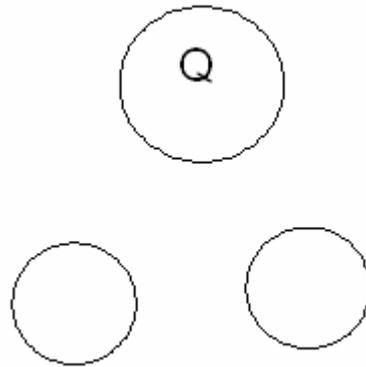
注意：不管什么样的电容， C 总是正比于一个某一个长度，具有长度的量纲。这事实上有很深的物理意义的。能量正比于 $C^{-1}qq'$ ， $C \sim L$ 线度说明了体系中两个电荷的“平均分开的有效距离”。

(5) 电容在现代科学中的应用

① 量子：电容是个经典量，电荷是一个个的。量子力学中，电子不是点电荷。小尺寸系统电容如何定义？

金属-----绝缘体相变

电容能，与量子效应的竞争，超导体量子点阵更是由电容能与量子效应的竞争。引发了一对新的物理量，number 与 phase 的竞争。



② 经典物理

负折射材料， C, L 共振改变物质的有效 ϵ_r, μ_r

(三) 电容的串联和并联

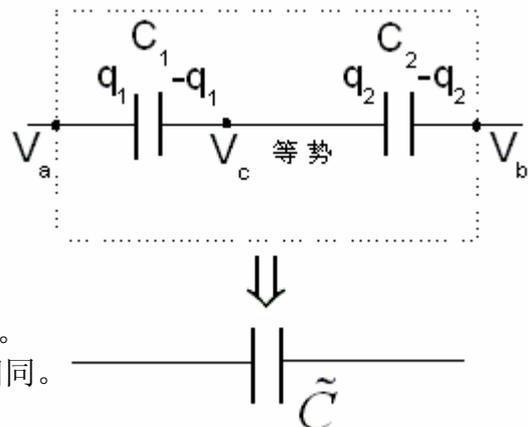
类似电阻，电容也有两种连接方式。

(1) 串联

静态平衡时，导线中没有电势差

孤立导体，电荷守恒 $q_1 = q_2 = q$ ，

两个串联的电容有效贮存的总电荷仍然为 q 。但其所占据的电势差却与单个电容的不再相同。



$$C_1 = \frac{q}{V_a - V_c} \quad V_a - V_c = \frac{q}{C_1}$$

$$C_2 = \frac{q}{V_c - V_b} \quad V_c - V_b = \frac{q}{C_2}$$

等效来讲

$$\Delta V = V_a - V_b = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}$$

贮存电荷 q ，因此总等效电容为

$$\tilde{C} = \frac{q}{V_a - V_b} = \frac{q}{\frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

即： $\tilde{C}^{-1} = C_1^{-1} + C_2^{-1}$

$$\Rightarrow \tilde{C}^{-1} = \sum_i C_i^{-1} \quad (\text{多个电容串联情形})$$

(2) 并联

$q = q_1 + q_2$ —— 从电池处充得的总电量

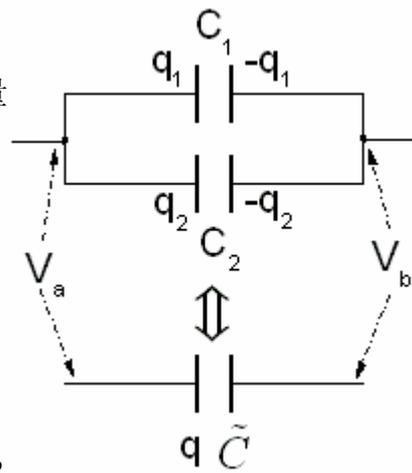
$V_a - V_b$ —— 电池给的总电压

$$q_1 = C_1(V_a - V_b)$$

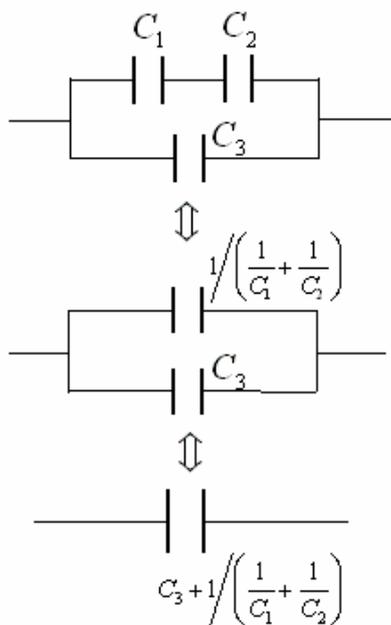
$$q_2 = C_2(V_a - V_b)$$

$$\tilde{C} = \frac{q}{V_a - V_b} = \frac{q_1 + q_2}{V_a - V_b} = C_1 + C_2$$

$$\Rightarrow \tilde{C} = \sum_i C_i \quad \leftarrow \text{并联情形}$$



(3) 既有并联，又有串联



如图所示

$$\tilde{C} = \frac{q}{\Delta V} = C_3 + \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

习题： P. 693 Questions, 15,
P. 696 Problems, 4, 8, 10, 20, 24

1. 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳所构成，球壳的内半径为 R_2 ，其间一半充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质，另一半为空气（如图所示）。设空气的相对介电常数为 1，求该电容器的电容 C 。

